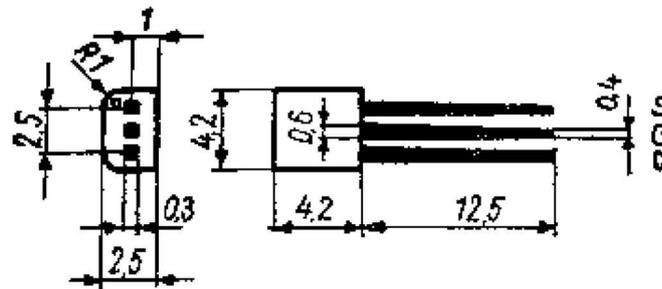


Silizium-MOS-Feldeffekt-Transistor (n-Kanal-Depletion-Typ) mit hoher Eingangsimpedanz für allgemeine Anwendung, Bauform L 3 nach TGL 200—8380. Das Substrat ist innerhalb des Gehäuses mit Source verbunden.



Masse ca. 0,3 g

Wärmewiderstand $R_{thch/a} \leq 0,6 \text{ grad/mW}$

Grenzwerte; gültig für den Betriebstemperaturbereich

Drain-Source-Spannung	U_{DSV}	= 20 V
Gate-Source-Spannung	U_{GS}	= -15 V bis +5 V
Drain-Gate-Spannung	U_{DG}	= 30 V
Drainstrom	I_D	= 15 mA
Gesamtverlustleistung bei $\theta_a = 25^\circ\text{C}$	P_{tot}	= 150 mW
Kanaltemperatur	θ_{ch}	= $\pm 125^\circ\text{C}$
Betriebstemperaturbereich	θ_a	= 0°C bis $+125^\circ\text{C}$

Statische Kennwerte ($\theta_a = 25^\circ\text{C} -5 \text{ grad}$)

		Min.	Typ	Max.
Drain-Source-Durchbruchspannung	$U_{(BR)DSV}$	20 V		
- U_{GS}	= 10 V			
I_D	= 10 μA			
Schwellspannung	- U_T		5,5 V	8 V
U_{DS}	= 8 V			
I_D	= 10 μA			
Drainstrom	- I_{DSS}	1,5 mA	4,5 mA	6,5 mA
U_{DS}	= 8 V			
U_{GS}	= 0 V			
Eingangswiderstand	R_a	$10^{12} \Omega$	$10^{14} \Omega$	
- U_{GS}	= 10 V			

Dynamische Kennwerte ($\theta_s = 25^\circ\text{C} - 5\text{ grad}$)

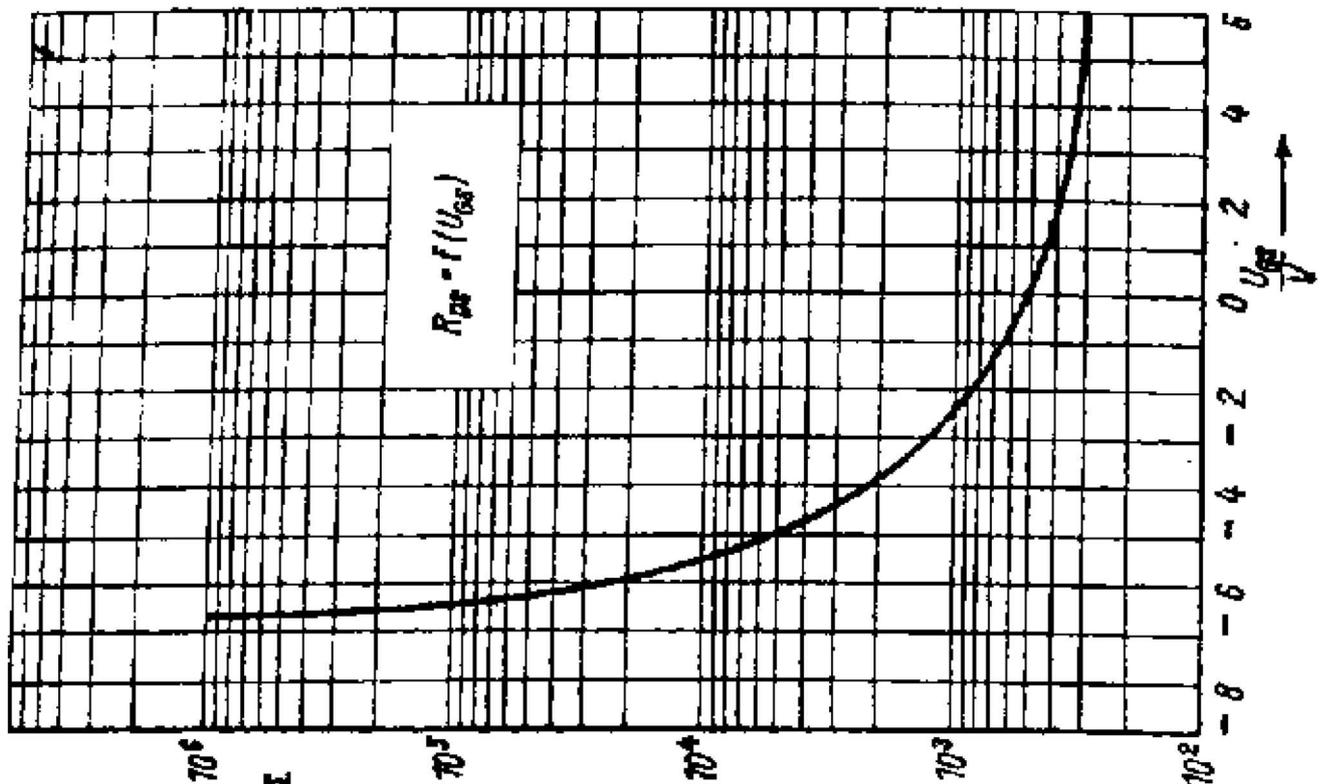
Steilheit y_{21} 1 mS 1,3 mS
 $U_{DS} = 8\text{ V}$
 $U_{GS} = 0\text{ V}$
 $f = 1\text{ kHz}$

Eingangskapazität c_{11} 5,2 pF 6 pF
 $U_{DS} = 8\text{ V}$
 $U_{GS} = 0\text{ V}$

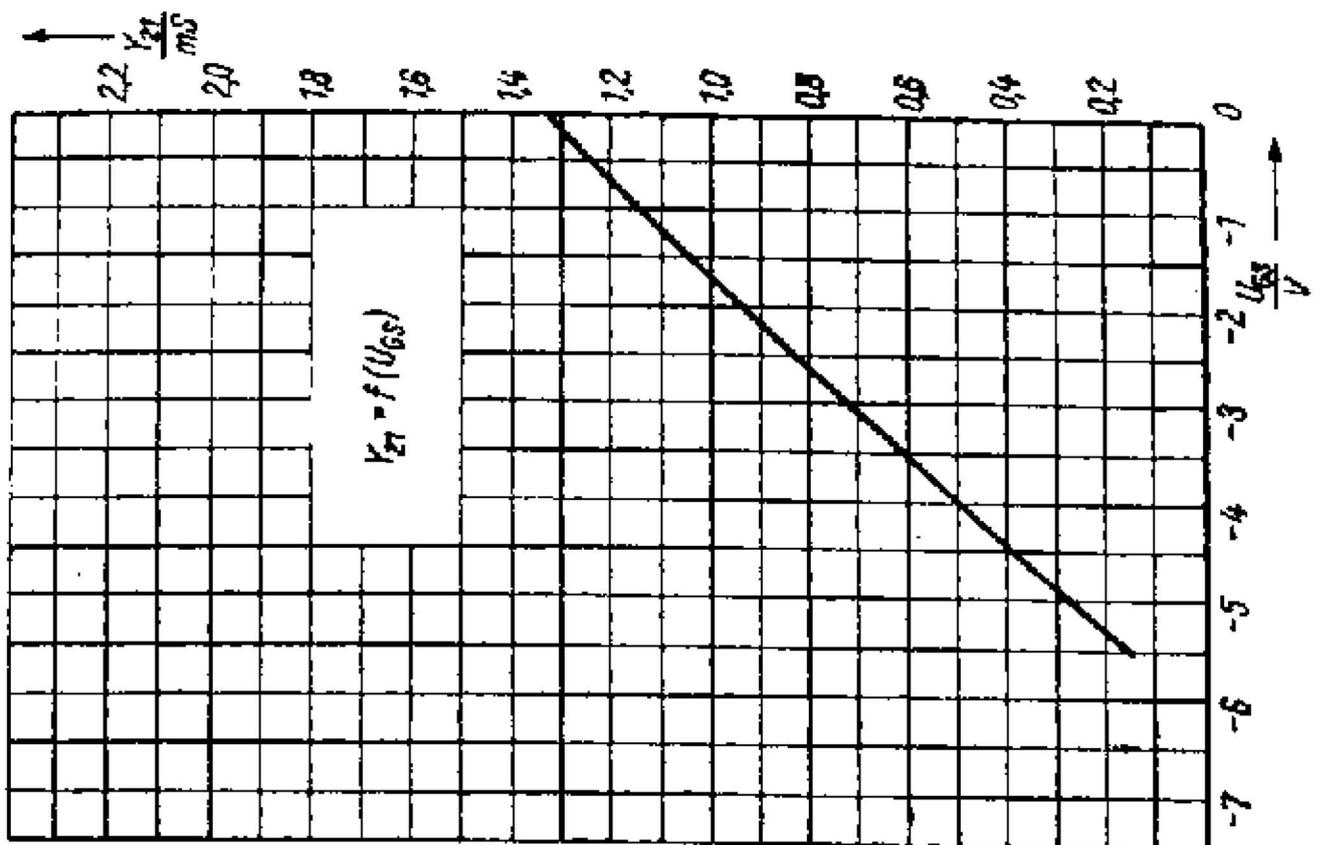
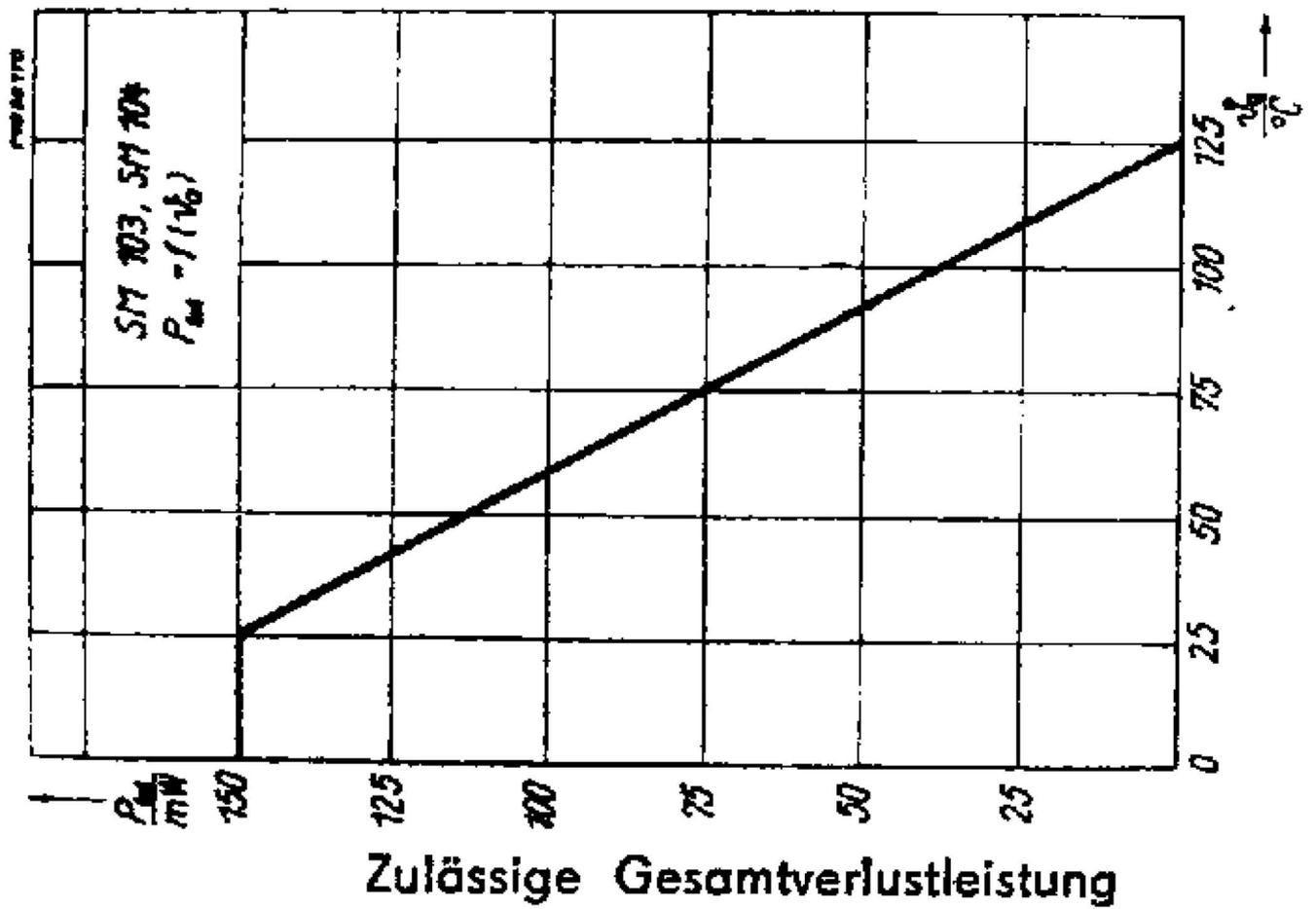
Ausgangskapazität c_{22} 2,5 pf
 $U_{DS} = 8\text{ V}$
 $U_{GS} = 0\text{ V}$
 $f = 1\text{ MHz}$

Drain-Gate-Rückwirkungskapazität c_{12} 1,2 pf
 $U_{DS} = 8\text{ V}$
 $U_{GS} = 0\text{ V}$
 $f = 1\text{ MHz}$

Ausgangsleitwert g_{22} 0,074 mS
 $U_{DS} = 8\text{ V}$
 $U_{GS} = 0\text{ V}$
 $f = 1\text{ MHz}$



Drain-Source-Widerstand
 bei $U_{DS} = 0,1\text{ V}$



Steilheit bei $U_{DS} = 8\text{ V}$

